

东芝分立器件

东芝高效节能功率MOSFET (U-MOSVI-H, U-MOSIX-H, DTMOSIV)

客户价值定位

- 东芝提供高性能MOSFET，具备高速、低损耗、低导通电阻等功能
- 封装及耐压范围广，可以满足您各种的应用需求

◆ 绿色节能

MOSFET的沟道工艺及超级节工艺使我们的产品可以提供更低的导通电阻和更高的开关速度性能

◆ 节省空间

我们使用最新的芯片封装技术在保证低导通电阻及高效率的基础上降低产品空间

◆ 应用广泛

我们功率MOSFET提供30V到800V范围内多种组合的耐压产品，可以满足您各种应用

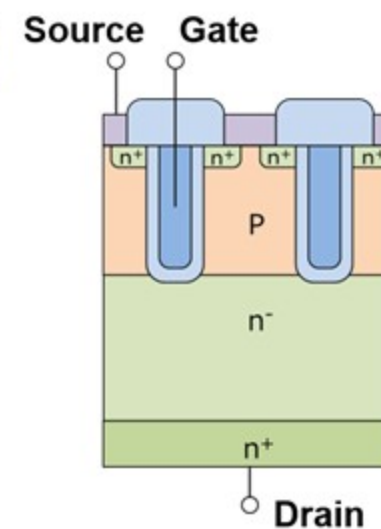
市场趋势

- 栅极的垂直沟道型结构可以提高集成密度，降低导通电阻

技术 / 特点

◆ 沟道工艺 (U-MOSVI-H, U-MOSIX-H)

栅极的垂直沟道U型结构可以提高集成密度，降低导通电阻



◆ 超级结工艺 (DTMOSIV)

P层的垂直构造工艺使得东芝DTMOS第IV代系列产品可以在拥有高耐压的同时保持低导通电阻的性能。

通过应用单层外延的工艺技术，DTMOS第IV代可以实现高性能、高效率，这主要得益于它精简的几何构造及生产过程。

